

УДК 621.382
С 247

*М.В. Світанько, доцент
Л.Л. Верьовкін, професор
С.Л. Хрипко, професор*

Відповідальний за випуск: *зав. кафедри МЕІС
проф. С.Л. Хрипко*

Світанько М.В.

С 247 Методи дослідження матеріалів та компонентів мікро- та нанoeлектронної техніки. Конспект лекцій для студентів ЗДІА спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В. Світанько, Л.Л. Верьовкін, С.Л. Хрипко – Запоріжжя: 2018. – 40 с.

Зміст

	Стор.
ВСТУП.....	4
1. Чотиризондовий метод вимірювання питомого опору напівпровідників...	6
2. Дослідження ефекту Холла.....	13
3. Визначення дифузійної довжини і часу життя нерівновісних носіїв струму у напівпровідниках.....	17
4. Дослідження поверхневих рівнів напівпровідникової структури за допомогою вольт-амперної характеристики МДН транзистора.....	21
5. Дослідження спектральних характеристик фото діодів на основі p-n – переходу і бар'єра Шоттки.....	24
6. Дослідження дифракції рентгенівських променів.....	31
Перелік посилань.....	40

ВСТУП

Дисципліна «Методи дослідження матеріалів та компонентів електронної техніки» є важливою для вирішення проблем контролю параметрів напівпровідникових структур: питомого опору, концентрації домішок, дифузійної довжини, часу життя носіїв заряду, фотолюмінісцентних характеристик, розподілу домішок, параметрів глибоких центрів. Особливу увагу приділено дослідженню кристалічної структури напівпровідників, нанорізмірних характеристик поверхневих станів.

Мета дисципліни - навчити студентів експериментальним методам виміру параметрів, які є основними для виробничого контролю якості матеріалів і структур і складають основу багатьох методів дослідження напівпровідників і напівпровідникових приладів.

Завдання дисципліни – ознайомлення студентів з основними методами вимірювання параметрів напівпровідникових кристалів та сполук, статистичної обробки отриманих результатів, формулювання аналітичних висновків за отриманими результатами вимірювань.

Дисципліна «Методи дослідження матеріалів та компонентів електронної техніки» дає достатні фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних досліджень в області технологічного контролю параметрів напівпровідникових структур, вирішення таких завдань:

- аналізу стану структур;
- проведення якісних наукових розрахункових завдань по моделюванню нових з'єднань;
- проектування експериментальних методів дослідження напівпровідників.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

- про основні сучасні методи вимірювання параметрів матеріалів, розуміти фізичні процеси, які лежать в основі цих методів, уміти пояснити вплив контрольованих параметрів матеріалів на характеристики приладів і структур на їх основі;
- принципи взаємозв'язку між вимірюваними параметрами напівпровідникового матеріалу і характеристиками хімічних домішок, глибоких рівнів і інших дефектів кристалічної решітки.

ВМІТИ:

- обґрунтовувати використання високоточних і продуктивних засобів вимірювання, а також сучасних методів неруйнівного контролю матеріалів.
- вимірювати основні параметри матеріалів, а також обробляти результати досліджень на комп'ютері.

1. ЧОТИРИЗОНДОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Провідність напівпровідників

Одним з основних електрофізичних параметрів речовини є її питомий опір ρ (Ом·см) або обернена їй величина – питома електрична провідність (Ом⁻¹·см⁻¹).

Розглянемо в якості приклада електронний напівпровідник [1]. Густина струму \vec{j} визначається концентрацією вільних носіїв n , середньою дрейфовою швидкістю $\langle \vec{V} \rangle$ і зарядом e [1,2]:

$$\vec{j} = en \langle \vec{V} \rangle \quad (1)$$

Середня швидкість дрейфа дуже просто пов'язана з параметром, який характеризує розсіяння носіїв заряду при їхньому русі у решітці кристала – середнім часом вільного пробігу носіїв $\langle \tau \rangle$, напруженістю електричного поля \vec{E} , зарядом і ефективною масою дірки чи електрона [1]:

$$\langle \vec{V} \rangle = \frac{e \langle \tau \rangle}{m} \vec{E} = \mu \vec{E}, \quad (2)$$

де μ – рухливість.

Таким чином, из (1), (2) маємо

$$\vec{j} = en \langle \vec{V} \rangle = en \mu \vec{E}, \quad (3)$$

а з закону Ома у диференціальній формі отримуємо, що величина $e \cdot n \cdot \mu$ має сенс питомої електричної провідності:

$$\sigma = en\mu = \frac{1}{\rho}. \quad (4)$$

Якщо є напівпровідник з обома типами носіїв заряду, то

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p). \quad (5)$$

Якщо напівпровідник легований домішковими атомами якогось одного типу з малою енергією іонізації (наприклад, атомами В, Р, Аs в Si і Ge), то наближено можна вважати, що вже за кімнатної температури усі домішки однонорово іонізовані, тобто $\approx N$ чи $p \approx N$, де N – повна концентрація домішки, що легує. І, якщо відомо μ , то по σ чи по ρ , які можна безпосередньо виміряти, визначається N . Концентрація легуючої домішки є дуже важливим параметром напівпровідникового матеріалу. Безпосередньо для найбільш важливих напівпровідникових матеріалів (Si, Ge, GaAs) обох типів N зручно визначати за графіком Ірвіна (див.рис.1.1) [1-4]

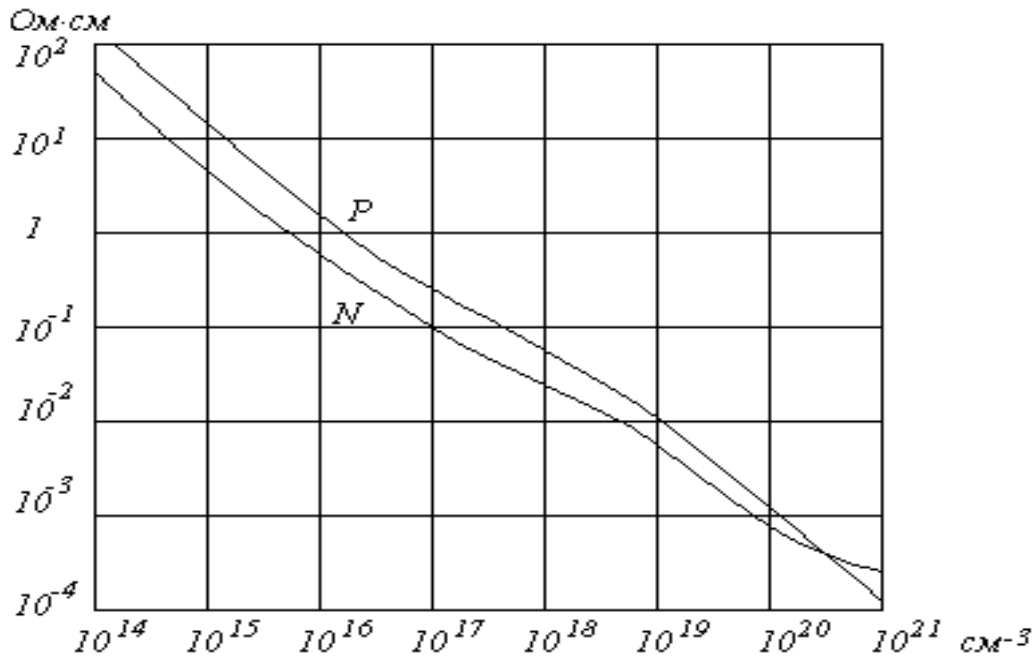


Рисунок 1.1 - Графік Ірвіна. Залежність питомого опору від концентрації легуючих домішок для напівпровідників *N* і *P* типу провідності

Цей графік отримано експериментально на основі багатьох вимірювань за кімнатної температури рухливості носіїв у напівпровідниках з відомою заздалегідь концентрацією домішки. При невеликих концентраціях домішки графік дає добру відповідність провідності і концентрації.

Визначаючи *N*, треба мати на увазі, що ця концентрація електрично активної домішки, а не повна концентрація, тому що при високих рівнях легування ці дві концентрації можуть відрізнятися.

Чотиризондовий метод визначення провідності напівпровідників

Методи вимірювання питомого опору можуть бути розділені на дві групи:

1. Вимірювання з приєднанням до зразка струмопровідних чи вимірювальних контактів.
2. Безконтактні вимірювання.

У даній роботі використовується перший метод.

У більшості випадків у місці контакту вимірювального зонду з напівпровідником виникає так звана контактна різниця потенціалів, яка впливає на результати вимірювань. У зв'язку з цим, величина опору напівпровідника, як правило, не може бути виміряна при простому включенні його у ланцюг омметра. Тому методика вимірювання питомого опору повинна забезпечувати або облік, або компенсацію цієї додаткової різниці потенціалів.

Крім цього, необхідно враховувати ті обставини, що на результати вимірювань можуть впливати розміри і форма зразка.

Найбільш поширеним методом визначення питомого опору напівпровідників (що дозволяє врахувати вищесказане) є чотиризондовий метод. Розглянемо його стосовно напівнескінченного зразка напівпровідника, обмеженого плоскою поверхнею. На цю поверхню, перпендикулярно до неї, розміщують 4 тонких гостро заточених металевих зонди (рис. 1.2). Усі чотири зонди розташовані на одній прямій. Через зовнішні зонди 1 і 4 пропускають електричний струм від джерела струму, а між зондами 2 і 3 вольтметром V вимірюють різницю потенціалів. Знаючи J_{14} і U_{23} , неважко знайти значення питомого опору. Дійсно, у припущенні напівнескінченності зразка кожний зонд створює навколо себе сферичне симетричне поле. У будь-якій точці

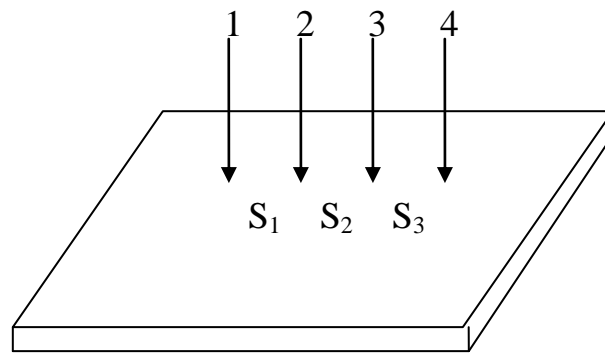


Рисунок 1.2 - Розташування зондів на пластині

на поверхні напівсфери радіуса r густина струму, напруженість поля і потенціал, тому, будуть визначатись наступним чином [2]:

$$j = \frac{J}{2 \cdot \pi \cdot r^2}; \quad E = j \cdot \rho; \quad \varphi = \rho \cdot j \cdot r = \frac{J \cdot \rho}{2 \pi \cdot r}. \quad (6)$$

Різниця потенціалів між зондами 2 і 3 повинна враховувати вплив поля крайніх зондів. Тому

$$U_{23} = \varphi_2 - \varphi_3 = \frac{J\rho}{2\pi} \left[\left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2+S_3} \right) - \left(\frac{1}{S_3} - \frac{1}{S_1+S_2} \right) \right] = \frac{J\rho}{2\pi \cdot S_{\text{ЭКВ}}}. \quad (7)$$

$$\text{Якщо } S_1=S_2=S_3=S, \text{ то } \rho = \frac{U_{23}}{J} \cdot 2\pi \cdot S. \quad (8)$$

Чутливість даного методу стосовно напруги $dU/d\rho$ пропорційна струму і обернено пропорційна $S_{\text{ЕКВ}}$. Струм через зразок збільшувати небажано (через термоелектричні ефекти при нагріванні зразка U_{23} може бути невірним), тому для підвищення чутливості можна збільшувати S_2 , зменшуючи S_1 і S_3 .

При $S_2 \gg S_1=S_3$ чутливість може бути збільшена приблизно у 2 рази.

Як уже зазначалося, при вимірюванні питомого опору напівпровідників основним джерелом похибок є перехідні опори на контактах метал-напівпровідник, а також термо-ЕРС, що виникає в них. Тому при визначенні питомого опору ці

явища повинні усуватися. Це досягається за допомогою компенсаційного методу. Принципова схема цієї компенсації при вимірюванні питомого опору напівпровідника чотиризондовим методом зображена на рис.1.3.

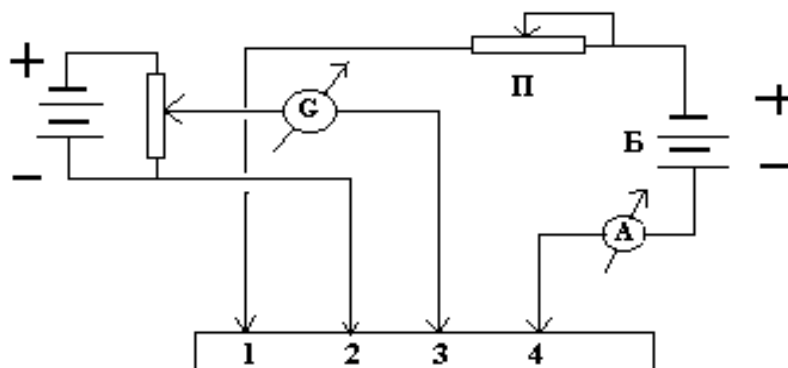


Рисунок 1.3 - Принципова схема компенсаційного методу

Від батареї Б за допомогою контактів 1 і 4 до напівпровідника подається струм. Різниця потенціалів між зондами 2 і 3 вимірюється потенціометром П.

Усунути вплив перехідних опорів контактів можна наступним чином. Різниця потенціалів між зондами 2 і 3 компенсується ввімкненою назустріч напругою потенціометра $U_{\text{П}}$, і, якщо ланцюг збалансований, тобто, $U_{2,3} = U_{\text{П}}$, то струм, що проходить через гальванометр G, дорівнює нулю. Отже, у момент балансу струм через вимірювальні зонди 2 і 3 також дорівнює нулю. Через те що струм відсутній, то немає і падіння напруги на контакті зонд-напівпровідник. У цьому випадку перехідні опори контактів не впливають на точність вимірювання питомого опору.

Зазвичай при вимірюваннях питомого опору завжди спостерігається деякий градієнт температури вздовж зразка, який викликає появу термо-ЕРС ΔU на вимірювальних зондах. Через те що величина і напрямок термо-ЕРС протягом достатньо тривалого часу залишаються постійними, її впливом можна знехтувати, вимірюючи напругу між зондами 2 і 3 при 2-х різних напрямках струму через зразок.

Застосування методу до зразків різноманітної геометричної форми

Формулу (8) можна застосовувати лише для однорідного ізотропного напівнескінченного середовища. Однак на практиці вимірювання виконуються на зразках граничних розмірів, причому досить часто це пластини, товщину яких можна порівняти з відстанню між зондами S , або дифузійні та епітаксіальні шари, товщина яких значно менше S . Це приводить до того, що еквіпотенціальні поверхні від зондів втрачають сферичність. При контакті з ізолюючим середовищем струм розтікається у меншому об'ємі, і густина струму у зразку збільшується порівняно з розрахунковою. При контакті з провідним середовищем лінії струму “випина-

ються” з неї; густина струму у зразку знижується. У першому випадку ми отримуємо завищені значення ρ , у другому – занижені.

Розглянемо питання більш детально:

а) нехай (рис. 1.4) відстань між зондами S , а відстань до границі з областю провідності l .

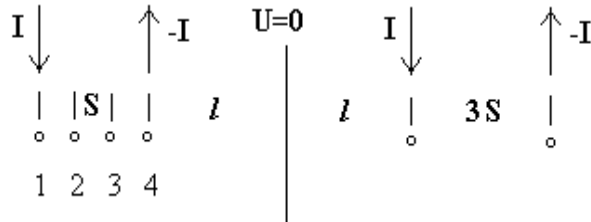


Рисунок 1.4 - Розташування дійсних та уявних джерел на провідній границі (вигляд згори)

Оскільки потенціал нескінченно віддаленої точки зразка дорівнює нулю, а обмежуюче середовище вважається абсолютно провідним (тобто, на ньому немає падіння напруги), то потенціал границі також дорівнює нулю.

Задача розподілу потенціалу вирішується методом дзеркальних зображень джерел. Для того, щоб потенціал границі дорівнював нулю, необхідно, щоб уявні джерела створювали на границі потенціал, який за величиною дорівнює потенціалу, який створюється дійсними джерелами струму протилежного знаку.

Цю умову можна виконати, якщо розташувати уявні джерела на тій же відстані від границі, але взяти їх з іншим знаком. Таким чином, розподіл потенціалу між зондами 2 і 3 можна розрахувати аналогічно (7) [1-4]:

$$U_{23} = \varphi_2 - \varphi_3 = \frac{J \cdot \rho}{2 \cdot \pi} \left[\frac{1}{S} - \frac{1}{2S} + \frac{1}{2S+2l} - \frac{1}{5S+2l} \right] - \left[\frac{1}{2S} - \frac{1}{S} + \frac{1}{S+2l} - \frac{1}{4S+2l} \right] \quad (9)$$

Питомий опір при цьому буде відрізнятися від (8):

$$\rho = 2\pi \cdot S \cdot f_1 \left(\frac{l}{S} \right) \cdot \frac{U}{J}, \quad (10)$$

де

$$f_1 = \left[+ \frac{1}{2+2l/S} - \frac{1}{5+2l/S} - \frac{1}{1+2l/S} + \frac{1}{4+2l/S} \right]^{-1} \quad (11)$$

– поправочна функція. Таким чином, наближення зондів до провідної границі еквівалентно ввімкненню додаткової провідності паралельно зондам. Тобто, якщо розрахувати питомий опір за формулою (8), то ми отримуємо занижені значення.

Поправочна функція f_1 завжди більше одиниці, але за умови $\frac{l}{S} > 2$ відмінність f_1 від 1 менше 1%.

б) якщо границя непровідна, то граничні умови треба накласти на струм: густина струму, перпендикулярного до границі, у будь-якій її точці дорівнює нулю. Ця задача також розв’язується за допомогою методу зображень, тільки для задоволення граничним умовам необхідно розташувати уявні джерела симетрич-

но відносно границі з тими ж знаками. Питомий опір обчислюється аналогічно (10):

$$\rho = 2\pi \cdot S \cdot f_2\left(\frac{l}{S}\right) \frac{U}{J}, \quad (12)$$

$f_2\left(\frac{l}{S}\right)$ – поправочна функція, значення якої для цього випадку завжди менше одиниці. (При $l/S > 2$ $f_2\left(\frac{l}{S}\right)$ також відрізняється від одиниці менше, ніж на 1%).

в) за тими ж причинами на результати вимірювань впливають і товщина зразка, і його форма. При цьому ρ визначається за формулою

$$\rho = \frac{U}{J} W \frac{\pi}{\ln 2} \cdot F\left(\frac{W}{S}\right). \quad (13)$$

Значення множника F при різних W/S для випадка ізольованої границі наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Значення множника F при різних W/S

W/S	0,4	0,5	0,5555	0,6250	0,7143	0,8333
$F\left(\frac{W}{S}\right)$	0,9995	0,9974	0,9948	0,9898	0,9798	0,9600
W/S	1,0	1,1111	1,25	1,4286	1,666	2,0
$F\left(\frac{W}{S}\right)$	0,9214	0,8907	0,8490	0,7938	0,7225	0,6336

З таблиці 1 видно, що при $W/S < 0,625$ значення $F\left(\frac{W}{S}\right)$ відрізняється від одиниці менше, ніж на 1%. Але цей результат справедливий, коли зонди знаходяться достатньо далеко від границь зразка, так що $l/S > 2$; при наближенні до границь зразка на результати вимірювань буде впливати як тип границі (провідна або непровідна), так і форма зразка. Товщина пластин, які застосовують у мікроелектроніці, як правило, набагато менше 1 мм, тобто, умови застосування формули (13) виконуються з більшим запасом по відношенню до W/S . Але ось форми зразків можуть бути різними. Тому необхідна модифікація чотиризондового методу для вимірювання питомого опору однорідних тонких пластин довільної форми. Цим вимогам відповідає метод Ван-дер-Пау.

Метод Ван-дер-Пау вимірювання питомого опору тонких однорідних пластин довільної форми

Нехай зонди розташовані на плоскому ребрі тонкої пластини, розташованої у нижній напівплощині (рис.1.5).

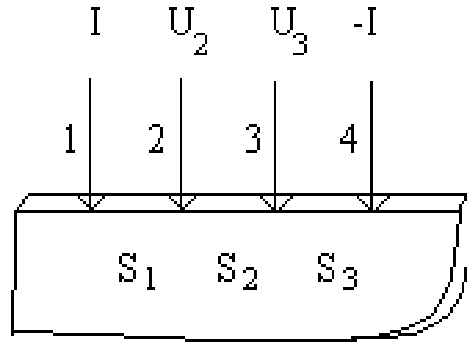


Рисунок 1.5 - Розташування зондів на ребрі пластини.

При пропусканні струму через зонди 1-4 потенціали контактів 2 і 3 знаходять з двувимірної картини розтікання струму у пластині:

$$U_2 = \frac{J_{14} \cdot \rho}{\pi \cdot W} \ln \frac{S_2 + S_3}{S_1} ; \quad U_3 = \frac{J_{14} \cdot \rho}{\pi \cdot W} \ln \frac{S_3}{S_1 + S_2} . \quad (14)$$

Введемо опір $R_1 = (U_2 - U_3) / J_{14}$:

$$R_1 = - \frac{\rho}{\pi \cdot W} \ln \frac{S_1 S_2}{(S_1 + S_2) \cdot (S_2 + S_3)} . \quad (15)$$

Аналогічно, пропускаючи струм через контакти 1-2 і вимірюючи різницю потенціалів ($U_4 - U_3$), знайдемо:

$$R_2 = \frac{U_4 - U_3}{J_{12}} = - \frac{\rho}{\pi \cdot W} \ln \frac{S_2 (S_1 + S_2 + S_3)}{(S_1 + S_2) \cdot (S_2 + S_3)} . \quad (16)$$

Потенціюючи логарифми для R_1 і R_2 і додаючи результати, отримуємо:

$$e^{-\frac{\pi \cdot W}{\rho} R_1} + e^{-\frac{\pi \cdot W}{\rho} R_2} = 1 . \quad (17)$$

Рівняння (17) у принципі вже дозволяє знайти ρ за вимірними значеннями R_1 і R_2 як корень трансцендентного рівняння. Можна спростити розв'язок цієї задачі. Представимо

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2}(R_1 + R_2) + \frac{1}{2}(R_1 - R_2); \\ R_2 &= \frac{1}{2}(R_1 + R_2) - \frac{1}{2}(R_1 - R_2) \end{aligned} \quad (18)$$

і підставимо їх у (17):

$$\exp\left(-\pi \cdot W \frac{R_1 + R_2}{2\rho}\right) \operatorname{ch}\left(\pi \cdot W \frac{R_1 - R_2}{2\rho}\right) = \frac{1}{2} . \quad (19)$$

Оскільки R_1 і $R_2 \sim \rho$, то можна припустити, що

$$\pi \cdot W \frac{R_1 + R_2}{2\rho} = \frac{\ln 2}{f(R_1, R_2)} , \quad (20)$$

де $f(R_1, R_2)$ – функція, залежна від R_1 і R_2 . Підставивши цей вираз у (19), знайдемо:

$$\exp\left(-\frac{\ln 2}{f}\right) \operatorname{ch} \left[\frac{R_1/R_2 - 1}{R_1/R_2 + 1} \cdot \frac{\ln 2}{f} \right] = \frac{1}{2}. \quad (21)$$

З (21) видно, що функція f , яка є коренем рівняння (21), дійсно залежить тільки від співвідношення R_1/R_2 . Графік $f(R_1/R_2)$ представлений на рис. 1.6.[1-4]

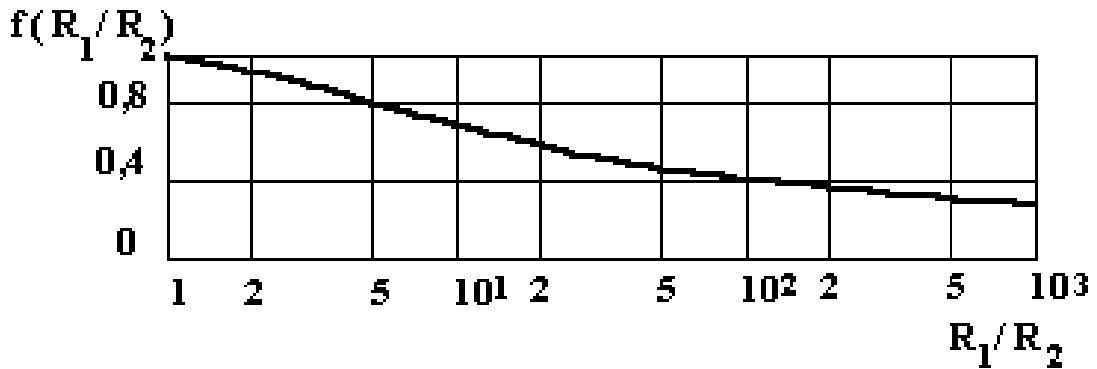


Рисунок 1.6 - Графік поправочної функції $f(R_1/R_2)$

Таким чином, знаючи $f(R_1/R_2)$, знайдемо ρ з (20):

$$\rho = \frac{\pi \cdot W}{\ln 2} \frac{R_1 + R_2}{2} f\left(\frac{R_1}{R_2}\right). \quad (22)$$

Якщо відношення $|R_1/R_2 - 1| < 0,1$, то $|1 - f| < 0,001$.

Згідно з теорією конформних перетворень можна показати, що співвідношення (19), (22) справедливі і для зразка будь-якої форми. Але при збільшенні площі контактів виникає додаткова похибка при вимірюванні ρ . Для усунення похибки, пов'язаної з величиною і формою контактів, застосовують зразки спеціальної форми (рис. 1.7).

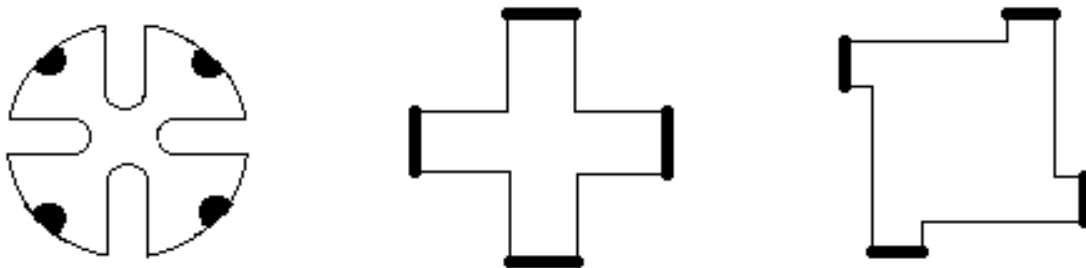


Рисунок 1.7 - Геометричні форми зразків для вимірювання питомого опору методом Ван-дер-Пау (місця контактів зачорнені)

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ХОЛЛА

Основні поняття

У 1880 р. було відкрито явище, яке згодом названо гальваноманітним ефектом Холла. Сутність ефекту Холла у наступному. Якщо пластинку провідника або напівпровідника, яким тече постійний електричний струм густиною \vec{j} , помістити в однорідне магнітне поле \vec{B} , перпендикулярне напрямку руху носіїв струму (рис. 2.1), то між двома точками протилежних боків пластинки (наприклад, А і С), розташованими на прямій, перпендикулярній як напрямкові струму \vec{j} , так і вектору магнітної індукції \vec{B} , виникає різниця потенціалів $\varphi_A - \varphi_C$, що називається ЕРС Холла \mathcal{E}_x . Величина цієї ЕРС за умови малої товщини d пластинки

$$\mathcal{E}_x = R_x \frac{IB}{d},$$

де
або

$$I = jS = jbd$$

$$\mathcal{E}_x = R_x b j B \quad (1)$$

де R_x – стала Холла; b – ширина пластинки.

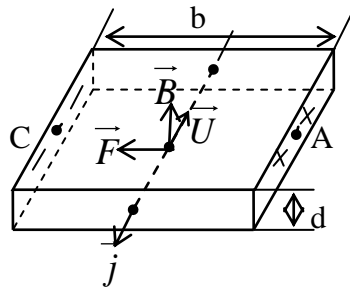


Рисунок 2.1 - Ефект Холла

Ефект Холла пояснюється дією магнітного поля на електричні заряди, що рухаються. За відсутності магнітного поля струм у пластинці обумовлений електричним полем \vec{E}_0 . Еквіпотенціальні поверхні цього поля утворюють систему перпендикулярних вектору \vec{E}_0 площин. Дві з них зображені на рис.2.1 суцільними лініями. Носії струму – електрони – мають від’ємний заряд, тому швидкість їх упорядкованого руху $\vec{u} = \frac{\vec{j}}{nq}$, (n – концентрація носіїв заряду, заряд електрона

$q = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл) спрямована протилежно вектору густини струму \vec{j} . У магнітному полі на носії струму діє сила $\vec{F} = q \vec{u} \times \vec{B}$, перпендикулярна середній швидкості упорядкованого руху носіїв струму \vec{u} і індукції магнітного поля. Під дією цієї сили носії струму відхиляються до одного з боків пластинки і накопичуються там, створюючи від’ємний заряд. На протилежній стороні пластинки буде залишатися

нескомпенсований позитивний заряд. У результаті виникає електричне поле \vec{E}_B , поперечне відносно \vec{E}_0 і \vec{B} (рис. 2.2).

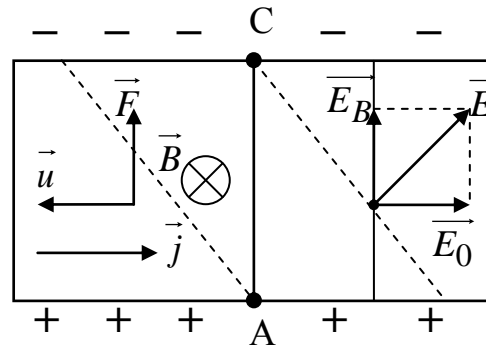


Рисунок 2.2 - ЕРС Холла у напівпровіднику

Сила $q\vec{E}_B$, що діє з боку поперечного електричного поля на заряд q спрямована у сторону, протилежну напрямку магнітної сили $\vec{F} = q\vec{j} \times \vec{B}$. У випадку рівноважного процесу проходження струму по пластинці ці сили взаємно врівноважуються, тобто

$$qE_B = quB. \quad (2)$$

Поля \vec{E}_0 і \vec{E}_B додаються, утворюючи результуюче поле \vec{E} . Еквіпотенціальні поверхні, перпендикулярні вектору напруженості поля \vec{E} , зображені на рис. 2.2 пунктиром. Точки А і С, що лежать на одній еквіпотенціальній поверхні, тепер належать до різних еквіпотенціальних поверхонь і мають різні потенціали. Враховуючи, що $\phi_A - \phi_C = \varepsilon_x = E_B b$, а $I = qnubd$, різниця потенціалів, що виникла між ними, дорівнює

$$\varepsilon_x = \frac{1}{nq} \cdot \frac{IB}{d}. \quad (3)$$

Коефіцієнт $R_x = \frac{1}{nq}$ є основною кількісною характеристикою ефекту Холла. Знак

R_x співпадає зі знаком носіїв заряду. Треба відзначити, що отримані результати справедливі лише приблизно. У вище викладеному матеріалі передбачалося, що всі носії струму рухаються з однаковою за величиною швидкістю, що дорівнює середній швидкості упорядкованого руху. У дійсності ж у різних носіїв струму швидкості їх руху неоднакові. З урахуванням розподілу носіїв струму за швидкостями, вираз для сталої Холла набуває вигляду:

$$R_x = \frac{A}{nq}, \quad (4)$$

де $A = \frac{3\pi}{8} = 1,18$.

Важливою характеристикою речовини є рухливість носіїв струму. Рухливість носіїв струму u_0 визначається середньою швидкістю, яку набувають носії при напруженості електричного поля, що дорівнює одиниці, тобто

$$u_0 = \frac{u}{E} \quad (5)$$

Записавши закон Ома у диференційній формі $j = \sigma E$ і враховуючи, що $j = nqu$, можна визначити рухливість, як

$$u_0 = \frac{\sigma}{nq} = R_x \sigma \quad (6)$$

де σ – питома електропровідність речовини.

Ефект Холла є одним з найбільш ефективних методів вивчення електричних властивостей металів і напівпровідників. Він використовується для перемноження постійних струмів в аналогових обчислювальних машинах, при вимірюванні індукції постійних і змінних магнітних полів, перетворенні постійного струму у змінний, вимірюванні потужності електромагнітних полів на надвисоких частотах і в інших галузях техніки.

У даній роботі використовується метод вимірювання ЕРС Холла у постійних електричному і магнітному полях.

Функціональна схема установки наведена на рис. 2.3.

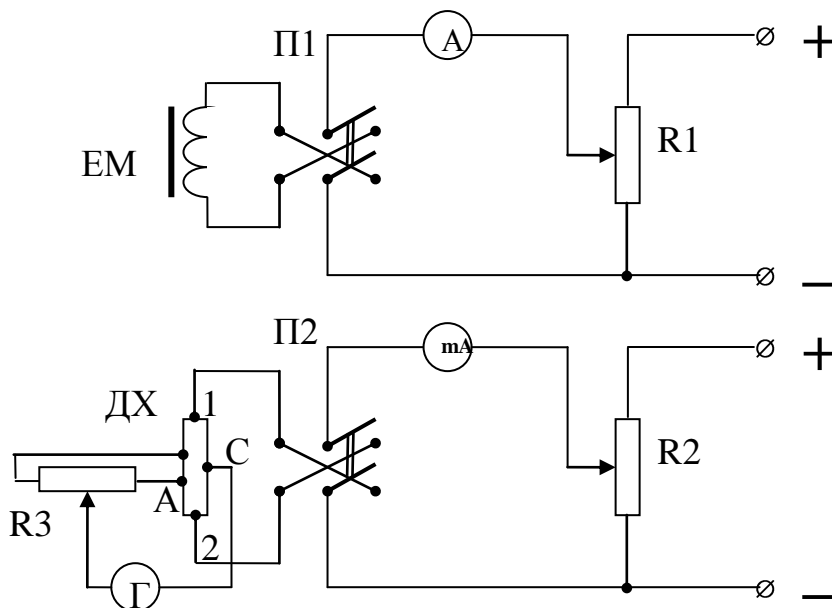


Рисунок 2.3 - Функціональна схема установки дослідження ефекту Холла

До напівпровідникового зразка або датчика Холла (ДХ) через електроди 1 і 2 подається струм, електроди А і С є зондами для вимірювань ЕРС Холла.

Утримувач з напівпровідниковим зразком розміщується між полюсними наконечниками електромагніта (ЕМ), підключеного до джерела постійного струму.

Величина струму, що йде через зразок, регулюється потенціометром R_1 і вимірюється міліамперметром (mA).

Зміна величини індукції магнітного поля у повітряному зазорі між полюсними наконечниками електромагніта здійснюється реостатом R_2 , а вимірювання значення струму I_{em} відбувається амперметром (А). Індукція магнітного поля визначається з виразу

$$B = \mu \mu_0 H = k \mu \mu_0 I_{em}, \quad (7)$$

де μ – відносна магнітна проникність сердечника електромагніта;
 k – коефіцієнт, що враховує конструктивні особливості електромагніта.

ЕРС Холла обчислюється за формулою

$$\varepsilon_x = I_\Gamma R_\Gamma, \quad (8)$$

де I_Γ – струм, що тече через гальванометр (Γ), R_Γ – внутрішній опір гальванометра.

Якби холлівські електроди на зразку були розташовані суворо симетрично, то при проходженні струму через зразок і за відсутності магнітного поля між електродами не виявлялося б ніякої різниці потенціалів. Однак розташувати їх суворо симетрично неможливо і між холлівськими електродами виникає різниця потенціалів U_R . Потенціометром R_3 вирівнюються потенціали на кінцях гальванометра, який за відсутності магнітного поля повинен показувати нуль. При ввімкненні магнітного поля виникає ЕРС Холла, і гальванометр показує наявність струму. Щоб упевнитися в тому, що гальванометр дійсно реєструє струм, обумовлений ЕРС Холла, треба плавно зменшити індукцію магнітного поля, потім перемикачем Π_1 змінити його напрямок на протилежний і знову плавно збільшити індукцію магнітного поля. Стрілка гальванометра при цьому повинна відхилитися у протилежну сторону.

Між холлівськими електродами, крім напруги U_R і ЕРС Холла, виникають і інші ЕРС, обумовлені гальваномагнітними і термомагнітними ефектами.

При визначенні величини ЕРС Холла для того, щоб виключити напруги, обумовлені побічними ефектами, вимірювання струму I_Γ необхідно проводити два рази при протилежних напрямках магнітного поля, а потім взяти середнє від отриманих значень [1-3]:

$$I_\Gamma = \frac{|I_{\Gamma 1}| + |I_{\Gamma 2}|}{2}. \quad (9)$$

За знайденими значеннями I_Γ і за величинами струму через зразок I і через електромагніт I_{em} визначається стала Холла

$$R_x = -A \frac{\varepsilon_x d}{I \cdot B} = C \frac{I_\Gamma}{I \cdot I_{em}}, \quad (10)$$

де $C = -\frac{1,18 R_\Gamma d}{\mu \mu_0 k}$ – калібрувальний коефіцієнт.

Значення μ , k , d і допустимі значення величин I і I_{em} вказані на робочому місці $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6}$ Гн/м.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ДИФУЗІЙНОЇ ДОВЖИНИ І ЧАСУ ЖИТТЯ НЕРІВНОВІСНИХ НОСІЇВ СТРУМУ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

Основні поняття

Якщо у напівпровідник за допомогою будь-якого способу (опромінення, інжекція) ввести нерівновісні носії струму, то система протягом деякого часу знову повертається у свій первісний (рівновісний) стан. Процес, що повертає напівпровідник у його первісний стан, називається *рекомбінацією*.

Дійсний стан рекомбінації ще не вивчений повністю. При рекомбінації в об'ємі напівпровідника основну роль відіграє механізм безвипромінювальної рекомбінації, зокрема визначальним фактором є рекомбінація через глибокі локальні центри (пастки).

Загальна схема рекомбінації на такій «пастці» може бути представлена наступним чином:

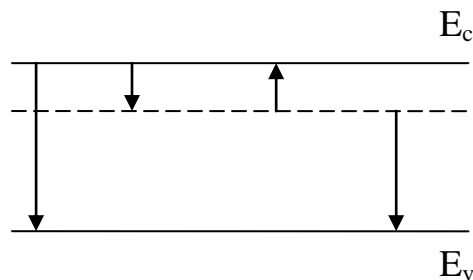


Рисунок 3.1 - Схема рекомбінації

Представимо, що у кристалі є дефект (домішка, механічний дефект і т.п.), який може захопити електрон. Якщо потім дірка опиняється у межах ефективного перетину центру, що вже захопив електрон, то електронний дефект захоплює цю дірку і рекомбінує з електроном. Імовірність рекомбінації носіїв на таких пастках визначається концентрацією останніх, їх природою. Кількісною характеристикою швидкості рекомбінації електронів і дірок є величина, що називається часом життя і визначається таким чином. Якщо надлишкова концентрація електронів або дірок « n » мала у порівнянні з концентрацією основних носіїв, то швидкість зменшення концентрації $\frac{dn}{dt}$ буде пропорційною надлишковій концентрації « n »

$$-\frac{dn}{dt} = \frac{1}{\tau} n \quad (1)$$

де τ – час життя електрона (дірки).

Інтегрування (1) дає

$$n_t = n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2)$$

де n_0 – концентрація у момент часу t_0 ,

тобто час життя – це величина часу, протягом якого концентрація нерівновісних носіїв зменшується у $e = 2,7$ разів.

Теорія методу

Розглянемо ниткоподібний напівпровідник (рис. 3.2), припустимо, що під впливом освітлення у внутрішній області «а» виникає додаткових носіїв в 1 см^3 за одну секунду.

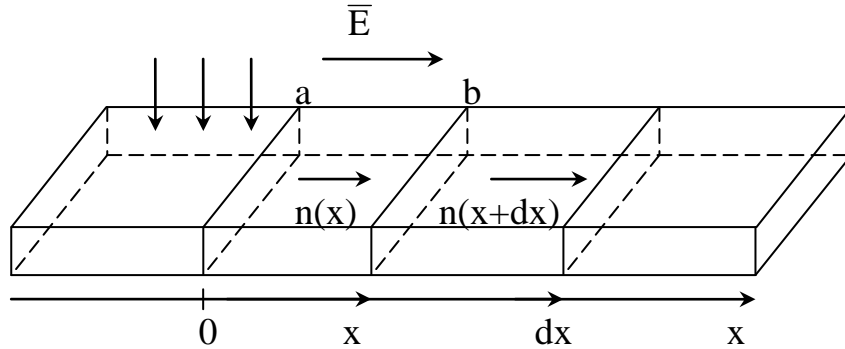


Рисунок 2.3 - Рух носіїв заряду у напівпровіднику під впливом світла

Розглянемо шар напівпровідника, обмежений площинами x і $(x + dx)$ через перетин x . Внаслідок дифузії входить $-D \frac{dn}{dx}$ число носіїв, а через перетин $(x + dx)$ виходить [1-4]:

$$-D \left(\frac{dn}{dx} \right)_{x+dx} = -D \left(\frac{dn}{dx} + \frac{d^2n}{dx^2} dx \right)_x$$

Отже, збільшення числа носіїв внаслідок дифузії є:

$$-D \left(\frac{dn}{dx} \right)_{x+dx} = -D \left(\frac{dn}{dx} + \frac{d^2n}{dx^2} dx \right)_x$$

Якщо у напівпровідникові присутнє електричне поле E , то носії беруть участь ще і у спрямованому дрейфовому рухові.

Число носіїв, які входять через перетин X внаслідок дрейфу, дорівнює:

$$n \leftarrow \mu E,$$

де μ – рухливість,

а число носіїв, які входять через $(x + dx)$

$$n \leftarrow + dx \mu E = \left(n + \frac{dn}{dx} \right) \mu E$$

Збільшення числа носіїв у шарі внаслідок дрейфу дорівнює:

$$n \mu E - \left(n + \frac{dn}{dx} \right) \mu E = -\mu E \frac{dn}{dx}$$

У стаціонарному стані повне число носіїв, які увійшли у шар, повинно дорівнювати числу носіїв, що зникають внаслідок рекомбінації, і дорівнює

$$-\frac{dn}{dt} dx = \frac{ndx}{\tau}$$

Тому рівняння балансу додаткових носіїв буде мати вигляд:

$$D^2 \frac{d^2 n}{dx^2} dx - \mu E \frac{dn}{dx} dx - \frac{ndx}{\tau} = 0$$

$$\frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{\mu E}{D} \cdot \frac{dn}{dx} - \frac{1}{D\tau} n = 0 \quad (3)$$

Дане рівняння справедливе тільки для низького рівня інжекції. Частинний розв'язок рівняння з початковими умовами має вигляд:

$$n_t = n_0 e^{-\frac{x}{\ell}}, \quad (4)$$

де ℓ – довжина затягування носіїв.

У межах випадку

а) $E = 0$, $\ell = \ell_0$ вираз (4) набуває вигляду

$$n_t = n_0 e^{-\frac{x}{\ell_0}}. \quad (5)$$

Довжина затягування дорівнює дифузійній довжині. Це відстань, на якій концентрація нерівновісних носіїв зменшується у e разів, при розгляді носіїв тільки внаслідок дифузії.

б) $\frac{\mu E}{2D} \gg \frac{\ell}{\ell_0}$, тоді вираз (4) набуває вигляду формули (2):

$$n_t = n_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Отримані результати лежать в основі експериментального визначення часу життя τ .

Ми бачимо, що для цього можна або досліджувати зменшення концентрації нерівновісних носіїв протягом часу і знайти τ за формулою (2), або досліджувати залежність від відстані вздовж зразку. В останньому випадку визначається дифузійна довжина ℓ_0 . Величину τ знаходять з співвідношення

$$D\tau = \ell_0^2 \quad (6)$$

Для вимірювання концентрації нерівновісних носіїв користуються двома методами. Перший ґрунтується на вимірюванні струму колектора. У випадку точкових контактів струм колектора буде пропорційним концентрації нерівновісних носіїв. Другий – на зміні потенціалу точкового контакту при збільшенні концентрації нерівновісних носіїв.

У даній роботі використовується перший метод, тому що він дозволяє проводити вимірювання ℓ_0 без додаткового посилення.

Методика вимірювань

Вимірювання проводиться на монокристалічному зразку Ge «р» типу провідності. Схема установки наведена на рисунку:

1. Модулятор
2. Мотор модулятора
3. Ламповий вольтметр
4. Індикатор переміщення часового типу

- 5. Голка
- 6. Лінза

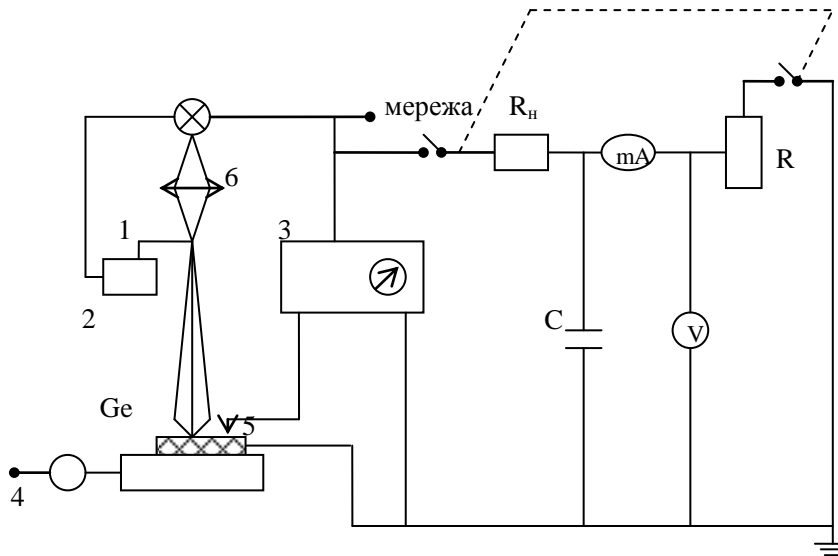


Рисунок 3.3 - Схема експериментальної установки

Установка зібрана на основі спектропроектора і містить: освітлювальну систему, рухливий стіл з закріпленому на ньому зразком, блок живлення, модулятор, індикатор часового типу для відліку повздовжнього переміщення столу і ламповий вольтметр.

Поверхня зразка освітлюється вузьким пучком світла у вигляді тонкої прямої лінії. Ця світлова смуга шириною декілька десятих міліметра перетинає усю верхню грань зразка паралельно його торцям. Така система освітлення полегшує розв'язок задачі дифузії неосновних носіїв і на певній відстані від освітленої ділянки дозволяє привести її до одномірної задачі, що розглядалася вище. Пучок світла переривається диском, що обертається, (модулятором). Це дозволяє відокремити частину колекторного струму, пов'язану з нерівновісними носіями, від сталої складової.

Частота переривання обирається таким чином, щоб за час освітлення установлювався рівномірний розподіл неосновних носіїв, а за час затемнення система приходила у рівноважний стан, тобто тривалості освітлення і затемнення повинні бути набагато більші за τ (~ 300 Гц).

Зсув на колектор подається від батареї B , величина зсуву регулюється потенціометром R . Колектор представляє електрично заточений W дріт. Опір колектора зазвичай досягає 100 кОм, тому струм через ввімкнений у ланцюг колектора визначається в основному опором колектора, з R_n знімається змінна складова колекторного струму на ламповий вольтметр. Таким чином, величина « U », що вимірюється ламповим вольтметром, прямо пропорційна концентрації n неосновних носіїв. Вимірюючи величину « U » на різних відстанях колектора від освітленої смуги, можна визначити дифузійну довжину l_0 . Для цього побудуємо графік залежності $\ln U = f(\dots)$. Котангенс кута нахилу цієї прямої визначає l_0 .

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ РІВНІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ СТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВОЛЬТАМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДН ТРАНЗИСТОРА

Сучасна мікроелектроніка в основному базується на приладах з структурою метал-діелектрик-напівпровідник (МДН), що пов'язано з простотою планарної технології, яка забезпечує у той же час високий ступінь інтеграції мікросхем при малих струмах споживання.

Вольтамперна характеристика ідеального МДН транзистора, отримана при наближенні плавного каналу при врахуванні тільки дрейфової складової струму і ряді інших припущень може бути записана у вигляді [3-5]:

$$I_D = \frac{Z}{L} \mu C_{ox} (V_G - V_T) V_D \quad (1)$$

де Z – ширина каналу, L – довжина каналу, μ – рухливість носіїв заряду, C_{ox} – ємність підзатворного діелектрика, V_G – напруга на затворі, V_D – напруга на стокі, V_T – порогова напруга.

Порогова напруга V_T відповідає початку сильної інверсії ($\psi_s=2\phi_0$), тобто формуванню інверсійного каналу і відкриттю транзистора. Наявність захопленого заряду у діелектрику Q_{ox} і на поверхневих станах Q_{ss} , а також контактної різниці потенціалів $\Delta\phi_{ms}$, приводить до зсуву порогової напруги:

$$V_T = 2\phi_0 + \Delta\phi_{ms} + \frac{-Q_{ox} + Q_{ss} + \sqrt{2\varepsilon_s \varepsilon_0 q N_B \phi_0}}{C_{ox}}$$

У лінійній області, коли справедлива формула (1), передаточна ВАХ $I_D(V_G)$ також лінійна і величина V_T може бути знайдена екстраполяцією графіка до осі абсцис (рис.4.1).

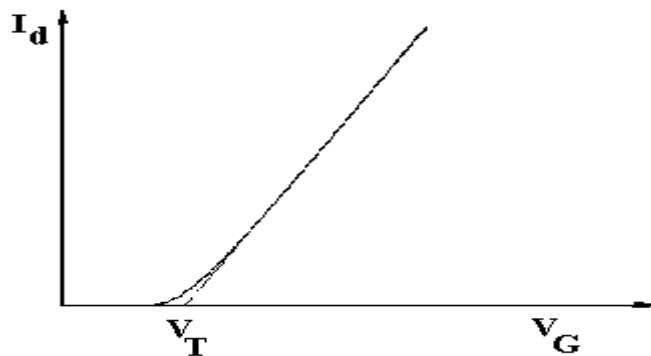


Рисунок 4.1 - Передаточна ВАХ у лінійній області

Тангенс кута нахилу $\text{tg}\alpha$ залежності $I_D(V_G)$ визначає величину рухливості μ :

$$\mu = \frac{L \cdot \text{tg}\alpha}{Z \cdot C_{ox} \cdot V_D}$$

В області насичення (в умовах відсікання каналу) передаточна ВАХ МДН транзистора $I_D(V_G)$ має квадратичну форму:

$$I_D = k \frac{Z}{L} \mu C_{ox} (V_G - V_T)^2 \quad (2)$$

Тому ВАХ спрямляється у координатах $\sqrt{I_D}$ і екстраполяція цієї залежності до нульового струму дає значення порогової напруги V_T , а тангенс кута нахилу прямої $\text{tg}\alpha$ визначає величину рухливості:

$$\mu_n = \frac{L \cdot \text{tg}^2 \alpha}{Z \cdot C_{ox}}$$

Для визначення величини концентрації легуючої домішки N_B користуються залежністю порогової напруги V_T від зсуву, зміщення канал-підложка V_{BS} в області плавного каналу:

$$\Delta V_T = \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_s \cdot N_B}{C_{ox}^2}} \cdot (\sqrt{2\varphi_0 + V_{BS}} - \sqrt{2\varphi_0})$$

Побудуємо залежність зсуву порогової напруги від деякої функції, що залежить від V_{BS} : $\Delta V_T = f(\sqrt{\psi_{s0} + V_{BS}})$ і по тангенсу кута нахилу $\text{tg}\alpha$ визначимо концентрацію

N_B як $N_B = \frac{\epsilon_{ox}^2 \cdot \epsilon_0}{2 \cdot q \cdot \epsilon_s} \cdot \left(\frac{\text{tg}\alpha}{d_{ox}}\right)^2$. При цьому треба врахувати, що величина φ_0 сама залежить від рівня легування підложки, проте знаючи, що ця залежність слаб-

ка: $\varphi_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_B}{n_i}$, то її можна вважати константою, наприклад $\varphi_0 = 0.3$ В.

При роботі у ключовому режимі чи низьковольтному живленні МДН транзистор може працювати при напругах на затворі поблизу порогової. У цьому випадку необхідно враховувати дифузійну складову струму, яка в умовах слабкої інверсії у приповерхневій області напівпровідника перевищує дрейфову компоненту.

Враховуючи тільки дифузійну складову струму стока I_D дорівнює:

$$I_D = -qSD_n \frac{dn}{dy} = qSD_n \frac{n(0) - n(L)}{L} \quad (3)$$

де $n(0) = n_{po} \exp(\beta\psi_s)$ – концентрація електронів у витока,

$n(L) = n_{po} \exp(\beta(\psi_s - V_D))$ – концентрація електронів у витока,

$\beta = q/kT$,

D_n – коефіцієнт дифузії,

$S = Z \cdot x$ – ефективна поперечна площа каналу,

$x \sim kT/E_s$ – глибина каналу, що залежить від поля E_s .

Розв'язком рівняння (3) буде підпорогова ВАХ:

$$I_D = \mu \frac{Z}{L} \frac{a C_{ox}}{2\beta^2} \frac{n_i^2}{N_B^2} \left(-\exp(-\beta V_D) \right) \exp(\beta V_G) \left(\beta \psi_s \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$a = \sqrt{2} \frac{\epsilon_s d_{ox}}{\epsilon_{ox} L_d} \quad (4)$$

де L_d – довжина Дебая.

Як видно з рівняння (4), залежність I_D від V_D дуже слабка тому що множник $(1 - \exp(-\beta V_D))$ при $V_D > 2kT/q$ ($V_D > 0.05$ В) дорівнює одиниці і струм стока залежить тільки від напруги на затворі V_G . Залежність ψ_s від V_G – складна, але сла-

бка, приблизно лінійна. Тоді підпорогова ВАХ буде носити в основному експоненціальний характер:

$$I_D \sim \exp(\psi_s) \sim \exp(V_G) \quad (5)$$

Нахил підпорогової характеристики g :

$$g = \frac{\partial \mathcal{V}_g}{\partial \lg I_D} = \ln 10 \frac{\partial \mathcal{V}_g}{\partial \ln I_D} \quad [B / декаду]$$

залежить від температури T і приблизно дорівнює

$$g \approx \ln 10 \frac{kT}{q} \left(1 + \frac{C_B + C_{ss}}{C_{ox}} \right) \quad (6)$$

де C_B , C_{ss} , C_{ox} – ємності області просторового заряду (ОПЗ), поверхневих станів (ПС) і окислення відповідно [4].

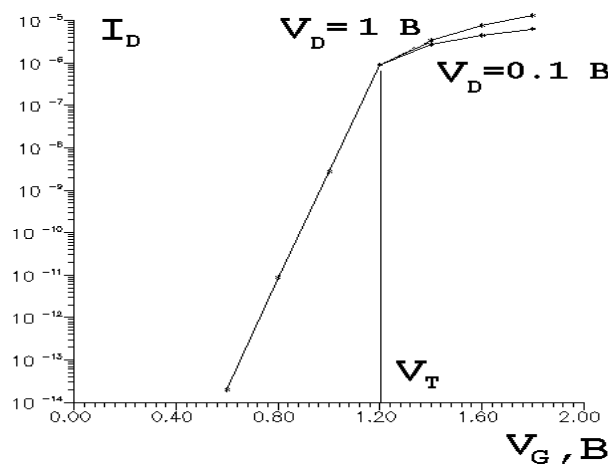


Рисунок 4.2 - Підпорогова ВАХ МДН транзистора

$$C_B = \sqrt{\frac{\epsilon_s \epsilon_o q N_B}{2 \left(\psi_s - \frac{kT}{q} \right)}}, \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox} \epsilon_o}{d_{ox}} \quad (7)$$

де d_{ox} – товщина діелектрика, ϵ_{ox} – діелектрична проникність діелектрика, ϵ_s – діелектрична проникність напівпровідника, N_B – концентрація легуючої домішки (рівень легування),

$$\psi_s = \varphi_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_B}{n_i}$$

φ_0 – положення рівня Фермі відносно середини зони, n_i – концентрація власних носіїв.

Таким чином, знаючи величини C_{ox} і C_B , можна по нахилу графіка $\lg I_D \sim V_G$ визначити C_{ss} , тобто і густину поверхневих станів N_{ss} :

$$N_{ss} = \frac{C_{ss}}{q} = \frac{C_{ox} \left(\frac{q}{kT \ln 10} g - 1 \right) - C_B}{q} \quad [cm^{-2} eV^{-1}] \quad (8)$$

Необхідно відзначити, що в величину N_{ss} входить не тільки дійсна густина поверхневих станів, але і певний внесок складають флуктуації поверхневого потенціалу ψ_s . Існують методи вимірювань дійсного значення N_{ss} , наприклад ме-

тод зарядової накачки (так званий СР-метод), однак він достатньо складний для експериментальної реалізації.

Блок-схема вимірювань підпорогової ВАХ мало відрізняється від стандартної схеми (рис.4.3).

У зв'язку з тим, що рівень вимірюваних струмів малий, тут застосовується електрометричний підсилювач струму і добра діелектрична ізоляція. З іншого боку, різка залежність I_D від V_G (десятки мілівольт на декаду) забезпечує точне регулювання напруги на затворі.

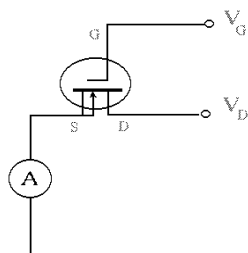


Рисунок 4.3 - Вимірювання підпорогової ВАХ МДН транзистора

5. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОДІОДІВ НА ОСНОВІ P-N-ПЕРЕХОДУ І БАР'ЄРА ШОТТКИ

Фізичні основи роботи напівпровідникових фотодіодів

Вступ

Фізичні основи напівпровідникових фотоприймачів і фотодіодів, зокрема, досить добре описані у відомій літературі [5-7]. Тому у даному розділі вони будуть викладені лише коротко.

Як відомо, для напівпровідникових фотоприймачів, що перетворюють енергію електромагнітного випромінювання в електричну, бажано, щоб у збудженому об'ємі провідника поглиналася як можна більша частина випромінювання, що падає. Одним із видів взаємодії випромінювання з напівпровідником, що лежить в основі принципу дії більшості фотоелектричних приладів, є генерація носіїв заряду фотонами. Поглинені напівпровідником кванти випромінювання звільняють носії заряду або з атомів кристалічної решітки, або з чужорідних (домішкових) атомів. Якщо енергія, яка передається фотоном електрону, є достатньою для того, щоб електрон залишив опромінене тіло, ми маємо справу з зовнішнім фотоелектричним ефектом. Якщо ж у результаті взаємодії фотона з атомом решітки або домішки звільняється електронно-діркова пара, що рухається в електричному полі, ми маємо справу з внутрішнім фотоелектричним ефектом. У напівпровідниках внутрішній фотоелектричний ефект проявляється у вигляді фотопровідності.

Напівпровідникові фотоприймачі з внутрішнім фотоелектричним ефектом (фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори, фототиристри, фотоприймачі на основі МДН-структур і приладів із зарядовим зв'язком) чутливі у широкій області спектра, вони можуть мати і селективну спектральну характеристику. Внутрішній фотоелектричний

дозволяє створювати фотоприймачі з великим внутрішнім коефіцієнтом посилення фотоструму (фоторезистори, лавинні фотодіоди, фототранзистори, фототиристри), реалізувати велику швидкодію (р-п-фотодіоди, фотодіоди з бар'єром Шоттки) створювати матриці фотоприймачів (на основі фоторезисторів, фотодіодів з бар'єром Шоттки, МДН-структур).

До фотоприймачів, як до перетворювачів оптичних сигналів в електричні, в оптоелектроніці пред'являються наступні вимоги [8]:

- спектральний розподіл fotocутливості, що відповідає спектральній характеристиці джерела випромінювання;
- висока fotocутливість, що визначає мінімальний рівень вхідного сигналу при заданому рівні вихідного;
- низький рівень шуму у заданій смузі частот і заданому коефіцієнті посилення, що визначає малий поріг чутливості і високу роздільну здатність;
- задані електричні параметри: опір, ємність, напруга живлення і струм, які визначають узгодження фотоприймача з навантаженням;
- широка смуга пропускання і великий динамічний діапазон, як по оптичному входу, так і по електричному виходу, що обумовлює велику швидкодію і можливість аналогового перетворення.

Фотодіоди з р-п-переходом.

У фотоприймачах з р-п-переходом, а також з бар'єром Шоттки внутрішній фотоефект викликає появу фото-ЕРС між областями пристрою, і тоді він називається фотовольтаїчним ефектом.

Діодні структури представляють собою основу більшості різновидів фотоприймачів, що використовуються у даний час у квантовій і оптичній електроніці. Простота їх конструкції забезпечує краще використання світлового потоку. Фотодіоди мають високі значення чутливості і швидкодії, мають лінійні характеристики у широкому діапазоні освітленостей, достатнє відношення сигналу до шуму при роботі фотодіода на узгоджене навантаження.

Якщо на структуру з р-п-переходом діє випромінювання в області довжин хвиль, які відповідають власному поглинанню у напівпровіднику, то під дією випромінювання в об'ємі напівпровідника (у р- і п-областях) генеруються електронно-діркові пари. У випадку, коли у р- і п-областях немає електричного поля, то носії заряду, що генеруються світлом, будуть розсмоктуватися у результаті дифузії. У процесі свого руху електрони і дірки рекомбінують, причому на відстані L , яка дорівнює дифузійній довжині, їх концентрація зменшується у e разів.

Частина фотоносіїв, які доходять до р-п-переходу, розділяються електричним полем переходу; при цьому збуджені неосновні носії заряду проходять через область переходу, а основні носії залишаються в області збудження. У результаті такого розділення в п-області структури будуть накопичуватися надлишкові електрони, а в р-області – надлишкові дірки. Це явище призведе до того, що п-область зарядиться від'ємно, а р-область – позитивно. При цьому утворюється додаткове електричне поле, протилежне існуючому внутрішньому електричному полю р-п-переходу, і знижує висоту потенціального бар'єра, як і у випадку прямого зсуву переходу. Величина, на яку знижується висота потенціального бар'єра, представ-

ляє собою фото-ЕРС, яку генерує р-п-перехід під дією випромінювання. Величина фото-ЕРС залежить від інтенсивності світла, ширини забороненої зони і навантажувального опору, ввімкненого у зовнішній ланцюг фотодіода.

Якщо ланцюг фотодіода розімкнутий, то всі надлишкові носії заряду, розділені р-п-переходом, скупчуються біля р-п-переходу, знижують потенціальний бар'єр на максимально можливу величину i , отже, створюють максимальне значення фото-ЕРС, яке дорівнює напрузі холостого ходу U_{xx} (робота у режимі фото-ЕРС або вентиляльному).

Якщо фотодіод замкнутий накоротко (нульовий навантажувальний опір), то розділені переходом носії заряду будуть циркулювати через цей коротко замкнений ланцюг, створюючи максимально можливе значення струму короткого замикання $I_{кз}$ (робота у режимі короткого замикання). При цьому біля р-п-переходу скупчення надлишкових зарядів не виникає. Потенціальний бар'єр буде мати ту ж висоту, що i у стані рівноваги р-п-переходу, і напруга холостого ходу дорівнюватиме нулю.

Якщо фотодіод замкнутий на кінцевий опір (так званий «гібридний» режим роботи), то частина розділених носіїв заряду витратить свою енергію на зниження потенціального бар'єра, тобто на створення напруги U_n , а частина надлишкових носіїв, що залишилась, створює струм I_n через навантаження.

Як бачимо, для збільшення чутливості фотодіода необхідно, щоб:

- освітлена область повинна бути тонкою, щоб генеровані носії могли досягати потенціального бар'єра;
- зворотна сторона пристрою повинна бути настільки широкою, щоб випромінювання, що проникає через фронтальну область, повністю поглиналось.

Струм фотодіода I_f пропорційний потоку фотонів $N_f = \frac{P_{hv}}{W_f} = \frac{\lambda P_{hv}}{hc}$.

Оскільки кількість фотонів за одиницю часу на одиницю потужності випромінювання пропорційна довжині хвилі, то спектральна характеристика чутливості для ідеального приймача повинна бути прямою лінією.

Однак для реальних фотодіодів спектральні характеристики фотовідповіді відрізняються від ідеальних внаслідок залежності від довжини хвилі випромінювання як коефіцієнта поглинання, так і величини квантового виходу (квантової ефективності) напівпровідникового матеріалу. Крім того, необхідно також враховувати і величину коефіцієнта розділення (чи збирання) носіїв заряду. Для ідеального фотоприймача з р-п-переходом коефіцієнт збирання дорівнює одиниці у всьому діапазоні довжин хвиль, до якого чутливий даний напівпровідниковий матеріал, тобто в області власного поглинання. У реальних же приладів за рахунок впливу різних втрат він менше за одиницю. Ця відмінність викликана ще і тим, що частина створених світлом носіїв рекомбінує один з одним або на домішкових центрах (в об'ємі і на поверхні), не доходячи до р-п-переходу. Втрати носіїв на рекомбінацію залежать від структури фотодіода, геометричних товщин р-п-областей переходу, розподілу концентрації домішок у р- і п-областях, дифузійних довжин неосновних носіїв заряду та ін. Як приклад розглянемо р-п-структури з різним розподілом домішок.

P-n-фотодіоди з однорідним розподілом домішки

Якщо фотодіод має структуру з однорідним розподілом концентрації домішки як в р-, так і в n-області, носії, які генеруються світлом, рухаються лише під впливом дифузії. Тому для такого типу фотодіода вважається, що полем р-n-переходу розділяється тільки та частина носіїв, яка генерується на відстані від переходу, рівному або меншому за дифузійну довжину L неосновних носіїв заряду у р- і n-областях. Чим далі від р-n-переходу створена електронно-діркова пара, тим з меншою ймовірністю вона буде розділена і дасть струм у зовнішньому ланцюзі. Оскільки пари створюються як у дірковій, так і електронній частинах р-n-переходу, то коефіцієнт збирання фотодіода буде складатися з двох частин: $Q = Q_n + Q_p$, де Q_n – коефіцієнт збирання електронів, створених у р-області, Q_p – коефіцієнт збирання дірок, створених у n-області.

Положення спектрального максимуму кривої $Q(\lambda)$ у різних фотодіодів може досить сильно відрізнятись. Дійсно, спад Q_p у короткохвильовій частині спектра (при освітленні фотодіода з боку р-області) пов'язаний з впливом втрат на рекомбінацію в об'ємі (об'ємна рекомбінація) і на поверхні фотодіода (поверхнева рекомбінація). Спад Q_n області коротких довжин хвиль викликаний зменшенням потоку випромінювання, що досягає р-області. Спад вказаних коефіцієнтів у довгохвильовій області обумовлений поглинанням квантів світла у n-шарі і в активній частині р-шару (на відстані L_n від р-n-переходу), тобто випромінювання проходить у глибину, слабо поглинаючись. Відносне розташування і величини максимумів кривих $Q_n(\lambda)$ і $Q_p(\lambda)$ залежать від співвідношення між геометричними товщинами р- і n-областей і дифузійними довжинами L_n і L_p неосновних носіїв заряду у цих областях. Вигляд цієї кривої $Q_p(\lambda)$, крім того, залежить від швидкості поверхневої рекомбінації s .

Коефіцієнт збирання для фотодіодів з тонкою базою, коли товщина бази w (товщина опроміненої області) набагато менше дифузійної довжини неосновних носіїв L , тобто $w/L \ll 1$, за умови однорідного розподілу концентрації домішок у базі є функцією параметрів αw , sw/D і w/L , де α – коефіцієнт поглинання світла [2], D – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв заряду. Вказаний параметр αw може бути інтерпретований як відношення товщини бази до середньої глибини проникнення випромінювання, що падає $1/\alpha$. Параметри sw/D і w/L характеризують відповідно втрати носіїв внаслідок поверхневої і об'ємної рекомбінації. Вплив поверхневої рекомбінації виявляється сильніше при великих коефіцієнтах поглинання світла. При $\alpha w \gg 1$ і $sw/D \gg 1$ коефіцієнт збирання зменшується обернено пропорційно швидкості рекомбінації.

P-n-фотодіоди з неоднорідним розподілом домішки в одній з областей

За наявності у базі фотодіода градієнта концентрації домішок виникає внутрішнє електричне поле, пропорційне градієнту концентрації:

$$E = \left(\frac{kT}{q} \right) \left(\frac{1}{N} \frac{dN}{dx} \right),$$

де N_A – концентрація акцепторів;
 $\frac{dN_A}{dx}$ – градієнт концентрації домішки у точці x .

Це поле прискорює дифузійний рух носіїв до р-n-переходу, що збільшує число носіїв у базі, яка розділяє р-n-перехід. Фотодіоди за наявності електричного поля у базі називаються дрейфовими.

Внутрішнє поле збільшує коефіцієнт збирання, але для невеликих значень αw , тобто для глибокого проникнення випромінювання, вплив поля на коефіцієнт збирання малий, тому що у цьому випадку р-шар стає майже прозорим для випромінювання і у базі створюється дуже мало неосновних носіїв. У випадку, коли випромінювання поглинається сильно, більшість фотонів поглинається у базі р-типу. У результаті цього в ній створюється багато неосновних носіїв і, отже, вплив внутрішнього поля стає більш відчутним.

Наведені положення справджуються при припущенні експоненціальної кривої розподілу акцепторної домішки. На сучасному рівні технології виготовлення напівпровідникових приладів у легованому шарі отримують і інші профілі: гаусівський і у вигляді функції похибок, які залежать від поверхневої концентрації домішки, відстані від поверхні, коефіцієнта дифузії і часу дифузії домішок. Такі профілі отримують у процесі іонно-променевого і дифузійного методів.

Для збільшення коефіцієнта збирання фотодіодів у довгохвильовій області спектра необхідно збільшувати дифузійну довжину неосновних носіїв заряду товщі напівпровідника. Високий коефіцієнт збирання в інтервалі довжин хвиль аж до 1,06 мкм (для кремнію) можна отримати, використовуючи для виготовлення фотоприймача матеріал з великою дифузійною довжиною і низькотемпературний (наприклад, іонно-променевий) метод створення р-n-переходу [9].

Інерційність фотодіодів з р-n-переходом

Інерційність фотодіодів з р-n-переходом, як можна бачити з попереднього розгляду, визначається часом перенесення носіїв заряду від місця їх генерації до розділення потенціальним бар'єром чи постійною часу RC – ланцюга еквівалентної схеми. Мало інерційні фотоприймачі зазвичай виготовляють так, щоб постійна часу RC була на порядок меншою за час перенесення носіїв.

Час перенесення носіїв визначається, як уже згадувалося, внутрішньою структурою фотодіода. Відомі три механізми переносу носіїв: а) дифузія; б) дифузія в електричному полі; в) дрейф в електричному полі. Дифузія є домінуючим механізмом переносу носіїв для р- і n-областей з рівномірним розподілом домішок. Коли товщина об'ємного заряду при оберненому зсуві має бути достатньо тонкою, так що час дрейфу можна не враховувати. Більш вигідною є конструкція з базою р-типу, оскільки коефіцієнт дифузії електронів D_n більше дифузійної постійної дірок D_p .

При поглинанні, яке відбувається по обидві сторони р-n-переходу, інерційність буде визначатися найбільшим часом перельоту для однієї з областей.

За наявності градієнта концентрації домішки, як ми вже бачили у попередньому розділі, створюється електричне поле, яке прискорює рух носіїв до переходу. Для дифузійних фотоприймачів з прискорюючим внутрішнім полем швидко-

дія може збільшуватися на порядок. Такі фотоприймачі мають високий коефіцієнт збирання і є більш ефективними.

Фотодіоди з р- і n-структурою

Фотодіоди з р- і n-структурою не мають зазначених вище недоліків фотодіодів з дифузійною базою. Наявність високоомної *i*-області дозволяє отримати досить довгу, тривалу область сильного електричного поля, достатню для ефективного поглинання випромінювання. Р- і n-структури, що зміщені в оберненому напрямку, використовують механізм переносу носіїв заряду шляхом дрейфу в електричному полі. Близько 90% потужності, що падає, поглинається *i*-областю і лише не більше 5...10% даремно витрачається у р⁺- і n⁺-областях. Навіть при невеликих обернених зсувах в *i*-області виникає сильне електричне поле, тому забезпечується швидке розсмоктування пар, які генеруються випромінюванням, малі рекомбінаційні втрати і велика швидкодія. Крім високої швидкодії р- і n-фотодіоди мають високі значення чутливості, обумовленої можливістю використання широкої *i*-області, малу ємність, високу ефективність при малих обернених напругах (зокрема, у вентильному режимі), що зумовлює їх сумісність з інтегральними схемами.

Фотодіоди на гетеропереходах

Фотодіоди на гетеропереходах мають ряд переваг з описаними вище конструкціями р-n-фотодіодів, які мають загальний недолік: вони вимагають, щоб р-n-перехід знаходився на дуже малій відстані від опроміненої поверхні. В іншому випадку навіть при нанесенні антивідбивного (просвітлювального) покриття, що зменшує втрати на відбиття випромінювання, ефективність фотоприймача буде малою. Виготовлення р-n-переходу на малій відстані викликає серйозні технологічні труднощі, потребує ретельного контролю і підтримання товщини поверхневого шару переходу.

Фотодіоди на основі гетеропереходів на відміну від гомогенних структур виготовлені з напівпровідникових матеріалів з різною шириною забороненої зони, у результаті чого виходить спектральна характеристика фотоприймача, що охоплює максимуми спектральної чутливості обох напівпровідників.

До переваг фотоприймачів з гетеропереходами можна віднести головним чином високу чутливість, обумовлену ефективним часом життя носіїв, високу швидкодію (внаслідок малого часу розсмоктування нерівновісних носіїв і малого значення бар'єрної ємності), можливість ефективної роботи при малих обернених напругах.

Ємність гетеропереходу дещо більша, ніж у р- і n-переходу, тому фотодіод з гетеропереходом потребує дещо меншого опору навантаження, з тим, щоб частотна характеристика не обмежувалася постійною часу зряду ємності. Це обмеження можна подолати підбором режиму роботи схеми.

Фотодіоди з бар'єром Шоттки

Фотодіоди з бар'єром Шоттки (з контактом метал-напівпровідник) з фізики роботи близькі до р- і n-фотодіодів. Вони є різновидом так званих поверхнево-бар'єрних фотоприймачів. З фізики напівпровідників відомо, що якщо на поверхню напівпровідника нанести метал, то внаслідок термодіфузійного переходу елек-

тронів у матеріал з більшою роботою виходу при границі напівпровідника з металом утворюється шар, з малою кількістю носіїв заряду.

Треба відзначити, що такий самий шар можна отримати також за рахунок спеціальної обробки поверхні напівпровідника, у результаті якої поверхневий шар на відміну від об'єму напівпровідника набуває іншого знаку провідності (інверсійний шар). Омичний контакт у такому шарі відбувається за допомогою нанесення тонкого (напівпрозорого) шару золота. Золото є хорошим провідником у тонких плівках і, крім того, маючи роботу виходу вище, ніж, наприклад, у кремнію і інших напівпровідникових матеріалів, створює додатковий вигин зон, покращуючи характеристику інверсійного переходу.

Однак звернемося знову до структури з бар'єром Шоттки. Якщо такій структурі, як і структурі з інверсійним шаром, буде надано обернену напругу, то воно практично повністю буде падати на цій області, і напруженість поля в ній виявиться значною. При освітленні структури генеровані електронно-діркові пари швидко втягуються цим полем, забезпечуючи високі значення швидкодії і великі величини струму у зовнішньому ланцюзі.

Спектральна характеристика поверхнево-бар'єрних приладів не має яскраво вираженого максимуму. У короткохвильовій і довгохвильовій ділянці спектральної характеристики чутливість відповідно вища, ніж у дифузійних приладів.

Важливою особливістю фотодіодів з бар'єром Шоттки є той факт, що, використовуючи прилади з бар'єром Шоттки, можна зсунути спектральні характеристики кремнієвих фотодіодів у довгохвильову область за край власного поглинання («червону» границю чутливості фотодіодів з р-n-переходом) [5] (див. також [10-15]). Фотони з енергією, меншою забороненої зон кремнію, проходять крізь пластину і поглинаються у металі, збуджуючи у ньому гарячі електрони. Висота внутрішнього бар'єра Шоттки на границі метал-напівпровідник визначається властивостями (роботою виходу) металу. Ті з збуджених електронів, які мають достатній імпульс у напрямку до бар'єра, переходять до границі, збідненої основними носіями області просторового заряду (у випадку лавинних фотодіодів тут може здійснюватися їх лавинне розмноження). Короткохвильова границя чутливості такого приладу визначається початком власного поглинання у напівпровідникові (кремнії), а довгохвильова границя – висотою потенціального бар'єра метал-напівпровідник, яка визначається різницею робіт виходу контактуючих напівпровідника і металу (золото, паладій чи ін.). Додатково підвищити чутливість приладу можна шляхом зменшення відбиття від поверхні металевої плівки. Подібні прилади можуть виготовлятися як в одиночному, так і у матричному виконанні.

Відомі лавинні фотодіоди з бар'єром Шоттки, чутливі до ближньої інфрачервоної області спектра. Так, фотодіоди на основі кремнію (напівпровідник) і паладію (метал) виявляють фоточутливість у діапазоні довжин хвиль 1 – 2 мкм, а при відповідному виборі контактуючого металу типу провідності кремнію і робочої температури область чутливості може бути розтягнута до і більше 4 мкм. Наприклад, прилади на основі р-типу Si/PtSi мають довгохвильову границю відсічення при 5,6 мкм. З використанням таких приладів були виготовлені фотопри-

йомні матриці форматом 1024×1024 пікселей, що дозволило добитися інфрачервоного зображення з високою роздільністю [12-17].

Лавинний фотодіод

Лавинний фотодіод відноситься до класу приладів з внутрішнім посиленням (до цього класу приладів відносяться також фототранзистори і фототиристри) Посилення сигналу відбувається за рахунок утворення лавинного процесу в області об'ємного заряду приладу за умови сильного електричного поля у цій області. В області об'ємного заряду відбувається лавинне розмноження неосновних носіїв заряду, які туди поступають, - електронів і дірок, які, набуваючи достатню енергію у сильному полі, стикаються з кристалічною решіткою і утворюють додаткову електронно-діркову пару. Додаткові пари у свою чергу здійснюють такий же процес, тобто відбувається розмноження. У результаті вхідний струм посилюється у M разів, де M – коефіцієнт множення.

Лавинні фотодіоди, які мають такі переваги, як висока чутливість, малі габарити і мала напруга живлення, мають і недоліки, що обмежують їх широке застосування. До недоліків відносяться температурна і часова нестабільність, залежність чутливості від рівня фонового засвічення, високі вимоги до стабільності напруги живлення, а також технологічні обмеження. До останніх відноситься наявність мікроплазм (локальних ділянок в області р-п-переходу), в яких лавинне розмноження відбувається раніше, ніж в іншій частині р-п-переходу. При цьому високий коефіцієнт множення фотодіода практично не реалізується. Для зменшення кількості мікроплазм використовують різні технологічні і конструктивні методи.

Все це обмежує застосування лавинних діодів. Тим не менше, як вже відзначалося, лавинні фотодіоди з бар'єром Шоттки ефективні для застосування в якості високочастотних фотодетекторів ультрафіолетового і видимого випромінювання. Лавинні фотодіоди отримали застосування у волоконно-оптичних лініях зв'язку. Інші області використання лавинних фотодіодів з бар'єром Шоттки були вже вказані вище.

6. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФРАКЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ

Рентгенівське випромінювання. Джерелами електромагнітного випромінювання рентгенівського діапазону ($\sim 800 \div 10^{-4} \text{ \AA}$) можуть бути радіоактивні речовини, що розпадаються, Сонце, Місяць, високо- і низькотемпературна плазма, двухелектродні трубки з напругою від декількох вольт до 10^8 В. Зазвичай короткохвильове R-випромінювання з довжиною хвилі $\lambda < 30 \text{ \AA}$ називають жорстким, довгохвильове – м'яким.

При бомбардуванні анода рентгенівської трубки швидкими електронами виникає рентгенівське випромінювання двох типів: з безперервним і дискретним спектром. Рентгенівське випромінювання з безперервним спектром виникає при

гальмуванні електронів у речовині анода (іноді – у речовині антикатода)¹. На рис. 6.1 представлено безперервний – гальмівний – спектр при різних значеннях прискорюючого потенціалу V трубки; мінімальна довжина хвилі λ_{ϕ} – так звана фіолетова границя гальмівного спектра – відповідає переходу енергії налітаючого електрона в енергію випромінювання без втрат на тепло, тобто визначається прискорюючим потенціалом.

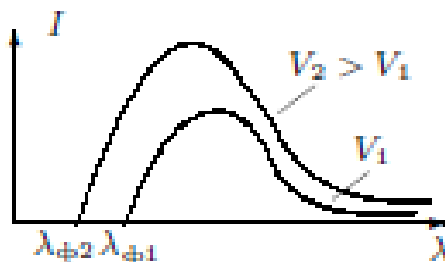


Рисунок 6.1 - Спектр гальмівного випромінювання

Дискретне, або характеристичне, випромінювання випромінюється збудженими атомами анода. Стан електрона в атомі характеризується енергією його зв'язку. Як відомо, енергія зв'язку електрона може приймати не будь-які значення, а лише певну дискретну сукупність значень, характерну для даного атома. При цьому енергія зв'язку буде максимальною у тому випадку, коли електрон розташований на ближній до ядра оболонці, і зменшується при його переході на більш високі оболонки. Для того щоб перевести електрон на одну з найвищих оболонок, необхідно передати йому енергію, яка дорівнює різниці енергії зв'язку у початковому і кінцевому станах. Якщо енергія, що була передана атомному електрону, є набагато більшою за його початкову енергію зв'язку, електрон переходить у вільний стан. У цьому стані енергія електрона може набувати будь-яких значень.

При переході електрона з високої оболонки (або з вільного стану) на більш низьку відбувається вивільнення енергії. Такі переходи відбуваються самовільно. Отримана таким чином енергія випромінюється у вигляді кванта випромінювання². Енергія кванта дорівнює різниці енергій зв'язку електрона у початковому і кінцевому станах. Чим більшою є ця різниця, тим більше енергія кванта, що випромінюється атомом, і тим жорсткішим буде випромінювання.

Рентгенівські кванти випромінюються при переході електронів на оболонки, що розташовані ближче до ядра. Найближча до ядра оболонка називається К-оболонкою (електрони на ній – К-електронами), наступна – L-оболонкою, потім M-, N- і т.д.

Припустимо, що напруга на рентгенівській трубці достатньо велика, так що енергія електронів, що бомбардують анод, перевищує енергію зв'язку К-

¹ Значна доля енергії електронів при гальмуванні переходить у тепло, тому у трубках використовується водяне охолодження, але якщо анод знаходиться від високою напругою, охолоджувати його водою небезпечно, тому для гальмування електронів перед анодом розміщують додаткову пластину – антикатод, який можна охолоджувати.

² Енергія, що вивільняється при переході електрона на нижчу оболонку, може і не випромінюватися, а передаватися іншому електрону (ефект Оже). Подальше випромінювання таких атомів є м'яким і у даній роботі не вивчається.

електронів. Енергія зв'язку електрона на вищих оболонках буде малою порівняно з енергією зв'язку К-електронів. Імовірність того, що К-електрону буде передано рівно стільки енергії, скільки потрібно для того, щоб перевести його у вищий збуджений стан, невелика. Більш імовірним буде процес повного видалення електрона з атома в область безперервного спектра, що вимагає ненабагато більше енергії, ніж перенесення його на далекі оболонки.

Атом з видаленим К-електроном нестійкий. Вільне місце у К-оболонці заповнюється електроном з будь-якої більш далекої оболонки, при цьому випромінюється спектральна лінія так званої К-серії. Найінтенсивнішими у К-серії є дві довгохвильові лінії: K_{α} (перехід з L-оболонки) і K_{β} (перехід з M-оболонки). Далі йдуть K_{γ} , K_{δ} і т.д. При заповненні порожнього місця у M-оболонці виникає серія ліній M_{α} , M_{β} , M_{γ} і т.д.

Як бачимо з попереднього матеріалу, збудження усіх ліній К-серії починається за однакової напруги на трубці, коли енергія прискорених у рентгенівській трубці електронів є достатньою для того, щоб вибити К-електрони з атомів антикатада. Тому можна говорити про порогову напругу серії, яка залежить від матеріалу анода. Збудження К-серії можливе тільки, коли напруга вище за порогову. Зазвичай анодна напруга у 3-4 рази перевищує порогову для того, щоб дискретний спектр яскравіше виділявся на фоні гальмівного. Вочевидь, що разом з К-серією виникають L-, M-серії і т.д.

Рентгенівське випромінювання в області 80^{-2} нм досліджують за допомогою дифракційних решіток з великою кількістю (числом) штрихів на мм (при непряму падінні), при менших довжинах хвиль – за допомогою кристалів, міжплщинні відстані яких можна порівняти з довжиною хвилі рентгенівського випромінювання [18,19].

Експериментальна установка. Використовується настільний рентгенівський апарат для структурного аналізу УРС-55 з мідним анодом (рис.6.2). Порогова напруга К-серії для міді дорівнює 8,95 кВ. Накал рентгенівської трубки R живиться від трансформатора T_3 . Кенотрон К випрямляє високу напругу. Кіловольтметр kV вимірює анодну напругу, а міліамперметр mA – величину анодного струму. Вода, що охолоджує трубку, повинна бути включена увесь час роботи установки.

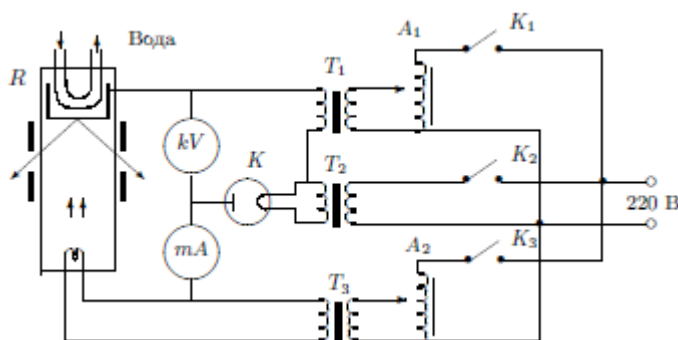


Рисунок 6.2 - Схема рентгенівської установки

Регулювання накалу трубки і високої напруги відбувається за допомогою автотрансформаторів A_1 і A_2 , що дозволяють змінювати напруги на первинних обмотках трансформаторів T_1 і T_2 .

У схемі є блокування, яке вимикає живлення за відсутності води, а також реле максимального струму, що вимикає схему при перевантаженнях рентгенівської трубки.

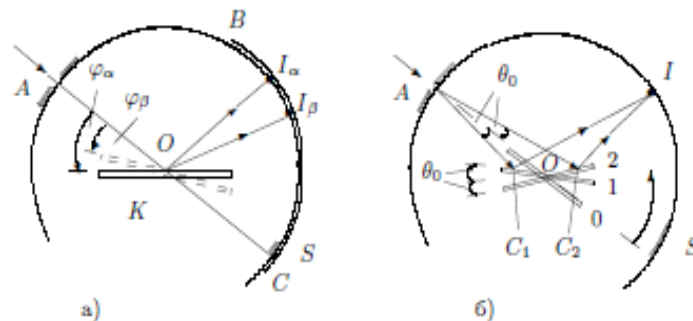


Рисунок 6.3 - а) Схема рентгенівського спектрометра Бреґґа, б) фокусуюча дія бреґґівського спектрометра.

Рентгенівське випромінювання виводиться з рентгенівської трубки по двом каналам у вигляді вузьких колімованих пучків. Один з пучків використовується для роботи з монокристалічними зразками (кам'яна сіль, слюда), інший – для роботи з полікристалами (мідь).

Дифракція рентгенівських променів у монокристалах

При роботі з монокристалічними зразками зазвичай використовують спектрометр Бреґґа. Схема спектрометра зображена на рис 6.3а. Щілина А і рентгенівська плівка ВС розташовується по колу радіуса r . Середина верхньої площини кристала К поєднується з центром кола О. Кристал гойдається навколо точки О за допомогою спеціального кулачкового механізму.

Інтенсивне відбиття рентгенівських променів від кристала відбувається у тому випадку, коли виконується умова Вульфа-Бреґґів [18,19]:

$$2d \sin \varphi = m\lambda \quad (1)$$

де d – міжплщинна відстань кристала, φ - кут ковзання, λ - довжина хвилі досліджуваної лінії, m – ціле число, що визначає порядок відбиття³. Кут падіння дорівнює куту відбиття.

Кожній лінії К-серії відповідає своя довжина хвилі - λ_α , λ_β і т.д. – і свій кут ковзання - φ_α і φ_β . Сильні відбиття, що виникають при кутах повороту кристала φ_α і φ_β (відносно падаючого пучка), призводять до появи чорних смуг I_α і I_β на рентгенівській плівці. На плівці видно також зображення S вхідної щілини А.

На бреґґівському спектрометрі можна робити фокусування за напрямком. Пучок променів, що проникає через щілину А, не нескінченно тонкий; припустимо, що він розходить під невеликим кутом $2\theta_0$ (рис.6.3б). У кожному положенні кристала умова Вульфа-Бреґґів виконана тільки для одного променя з діапазону

³ Умову (1) легко отримати з формули для інтерференції у плоскопаралельній пластинці.

$2\theta_0$: для промені AC_1 , якщо кристал у положенні 1, для AC_2 у положенні 2 або для одного з променів у проміжному положенні кристала. У відповідні моменти часу для цих променів виникає сильне відбиття.

Спектрометр дає чітке зображення щілини A на плівці тільки у тому випадку, якщо всі відбиті промені зберуться в одній точці I , тобто якщо спектрометр фокусує відбиті промені.

Покажемо, що спектрометр, що розглядається, дійсно має властивість фокусування. Простіше за все зробити це наступним чином. Проведемо лінії IC_1 і IC_2 . Відбиті промені будуть співпадати з цими лініями тільки у тому випадку, якщо виконується умова

$$\angle AC_1I = \angle AC_2I = \angle AOI = \pi - 2\varphi, \quad (2)$$

де φ визначається формулою (1). При цьому рівняння

$$\angle AC_1I = \angle AC_2I \quad (3)$$

виходить з симетрії рис.6.3а.

Розглянемо тепер кут ACI , де C – довільна (будь-яка) точка кристала. Цей кут є функцією кута θ і може бути представлений у вигляді ряду Тейлора:

$$\angle ACI = \angle AOI + a_1\theta + a_2\theta^2 \dots, \quad (4)$$

де a_1 a_2 – деякі константи. Для кутів AC_1I і AC_2I кут θ приймає рівні за величиною і протилежні за знаком значення $\pm\theta_0$. Приймаючи до уваги співвідношення (3), отримаємо, отже, $a_1 = 0$. Константа a_2 нулю не дорівнює.

Отже, кут ACI у першому наближенні не залежить від θ . Залежність проявляється тільки у наступних наближеннях. Тому для малих кутів умова (2) виконується; напрямки C_1I , C_2I і усі проміжні напрямки CI будуть напрямками відбитих променів, і у I виходить чітке зображення вхідної щілини A . Треба відзначити, що у вихідних променях зображення S вхідної щілини (див. рис.6.3б) виходить, навпаки, широким, несфокусованим.

Фокусування в I має місце тільки у першому порядку розкладання по θ (так зване фокусування першого порядку). Для більших кутів, коли у (4) починає грати роль член, пропорційний θ^2 , фокусування порушується, що змушує працювати з не дуже широкими пучками. Обмежують пучок за допомогою діафрагм.

При вивченні дифракції рентгенівських променів у монокристалах в якості зразків використовуються кристали кам'яної солі і слюди. Для обох кристалів використовується один і той же спектрометр; переставляються тільки пластинки, на які наклеєні кристали; на одній – кам'яна сіль, на іншій – слюда.

Налаштування спектрометра Брегга заключається у суміщенні вісі обертання столика з верхньою гранню монокристалічного зразка, а також в установці діапазону гойдання столика таким чином, щоб кут ковзання рентгенівського променя міг змінюватися від нульового до максимально можливого.

При розшифровці рентгенограми вимірюють відстані x_α і x_β на плівці від зображення щілини S до зображення ліній K_α ($\lambda_\alpha = 0,1539$ нм) і K_β ($\lambda_\beta = 0,1389$ нм) (до I_α і I_β) усіх порядків. З рис. 6.3а виходить, що

$$\varphi_{\alpha} = \frac{x_{\alpha}}{2r}; \quad \varphi_{\beta} = \frac{x_{\beta}}{2r}. \quad (5)$$

У нашій установці радіус спектрометра $r = 125$ мм. Отримані значення кутів підставляють у рівняння Вульфа-Бреггів (1).

Якщо на спектрограмі ми бачимо лінії різних порядків, початок відліку можна вилучити з розрахунків, використовуючи координати усіх отриманих ліній і вважаючи кути малими ($\sin \varphi \cong \varphi$).

Дифракція рентгенівських променів у полікристалах

Рентгеноструктурний аналіз можна проводити не тільки на великих одиночних кристалах, але і на полікристалічних зразках (спресовані порошки, металевий дріт і т.д.). Такий спосіб аналізу має назву методу Дебая-Шерера.

Спектрограми полікристалічних зразків мають найпростіший вигляд при роботі з монохроматичним рентгенівським випромінюванням. Як уже пояснювалося вище, при роботі з монокристалами необхідно змінювати нахил зразка відносно падаючого пучка. При вивченні полікристалів це не обов'язково, оскільки серед численних кристалів, що входять до складу зразка, завжди знайдуться кристали, орієнтовані так, що виконується умова Вульфа-Бреггів. Відбиті від даної кристалічної площини промені утворюють конус, вісь якого спрямована по променю, що падає. Кут при вершині конуса дорівнює 4φ .

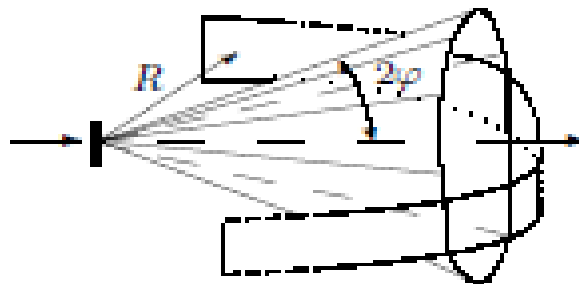


Рисунок 6.4 - Утворення ліній на рентгенограмі полікристалічного зразка

Розташуємо навколо зразка смугу фотоплівки, яка згорнута у вигляді циліндра і розміщена так, що падаючий пучок проходить по його діаметру. Конус відбитих променів перетинає циліндричну поверхню плівки по деякій кривій. Після проявлення на плівці побачимо сліди від її перетинання конусами променів, відбитих від різних кристалічних площин, які відповідають різним порядкам відбиття. Отримана таким чином спектрограма має назву дебаєграми.

По дебаєграмі може бути визначена структура кристала. Зазвичай дебаєграми знімають не на монохроматичному випромінюванні, а на характеристичному випромінюванні К-серії, що містить дві інтенсивні лінії K_{α} і K_{β} . Це трохи ускладнює розшифровку дебаєграм.

Деякі відомості з теорії рентгеноструктурного аналізу

Ми обмежимося розглядом найпростіших кристалічних решіток, що відрізняються кубічною симетрією. До них відносяться проста, об'ємноцентрована і гранецентрована решітки (рис. 6.5).

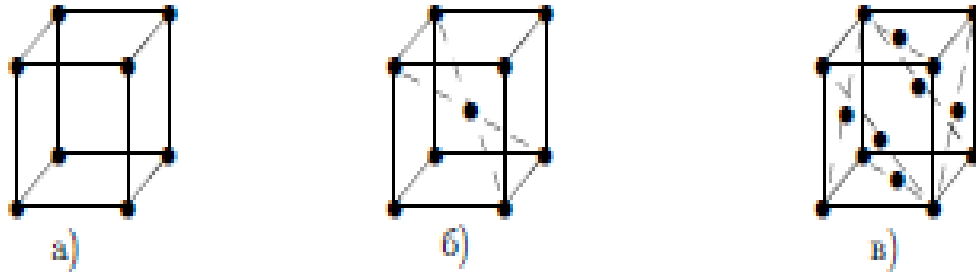


Рисунок 6.5 - Кубічні решітки: а) проста, б) об'ємноцентрована, в) гранецентрована

Характерним розміром елементарної кубічної комірки є довжина ребра куба a . У кожній з решіток відбиття рентгенівських променів може відбуватися від різних кристалографічних площин. Спрямуємо координатні осі по ребрам кубічної решітки. Орієнтацію кристалографічних площин прийнято задавати за допомогою трьох цілих чисел h, k, l , які не містять спільного множника. Ці числа, які називають індексами Міллера, визначають проекцію нормалі до розглядуваної площини на осі координат (якщо ця проекція негативна, то над числом проводиться риска).

Можна показати, що індекси Міллера обернено пропорційні відрізкам, які відтинає кристалографічна площина на осях координат. Зокрема, три грані елементарної кубічної комірки мають індекси $[100]$, $[010]$ і $[001]$. Кристалографічні площини, що приходять через діагоналі двох протилежних граней кубічної комірки, характеризуються індексами $[011]$, $[101]$ і $[110]$ і т.д. (рис. 6.6).

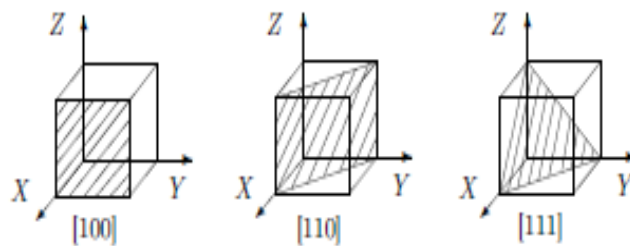


Рисунок 6.6 - Індеси Міллера для деяких кристалографічних площин кубічного кристала

Розрахунок показує, що відстань d між двома сусідніми паралельними кристалографічними площинами визначається за формулою

$$d^2 = \frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}. \quad (6)$$

Підставляючи (6) в (1), знайдемо, що умова Вульфа-Бреггів для відбиття від відповідних площин має вигляд

$$\sin^2 \varphi = \frac{m^2 \lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + \ell^2). \quad (7)$$

Формула (7) виражає умову того, що відбиття від усіх площин, які проходять через атоми, розташовані у вузлах кубічної решітки, опиняються у фазі один з одним. Тому ця формула правильно описує напрямки максимального відбиття у кристалах, що мають просту кубічну решітку. Якщо кристал має об'ємноцентровану або гранецентровану решітки, треба врахувати також відбиття від площин, що проходять через «додаткові» атоми. Якщо відбиття від цих площин опиняються у фазі з відбиттями від площин, що проходять через «основні» атоми, інтенсивність максимумів збільшується. Якщо ж вони знаходяться у протифазі, то інтенсивність зменшується. Детальний розгляд цього питання показує, що у об'ємноцентрованої решітки відбиття спостерігаються лише у тому випадку, якщо

$$h^2 + k^2 + \ell^2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \dots, \quad (8)$$

при цьому сума індексів парна.

У гранецентрованої решітки

$$h^2 + k^2 + \ell^2 = 3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, 20, \dots \quad (9)$$

Усі три індекси такої решітки або парні, або непарні.

У простій кубічної решітки індекси Міллера можуть приймати будь-які цілі значення:

$$h^2 + k^2 + \ell^2 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, \dots \quad (10)$$

Аналіз індексів $[hkl]$, для яких експериментально спостерігаються дифракційні максимуми, дозволяє вирішити, до якого типу належить решітка досліджуваної речовини. Більш детальні відомості про кристалічні решітки можна знайти у рекомендованій літературі.

Треба підкреслити, що при розшифровці рентгенограм зазвичай у формулі (7) приймають $m = 1$, оскільки інтерференційні максимуми більш високого порядку ($m = 2, 3, \dots$) співпадають з максимумами першого порядку для площин з більш складними індексами. Так, другий інтерференційний порядок для площини $[001]$ співпадає з першим порядком для площини $[002]$ і т.д. У цьому випадку, використовуючи формулу (7), можна розрахувати довжину ребра куба $[20]$:

$$a = \frac{\lambda \sqrt{h^2 + k^2 + \ell^2}}{2 \sin \varphi}. \quad (11)$$

Визначивши тип комірки, можна розрахувати число атомів N , що належать одній комірці. Так, наприклад, для простої кубічної решітки кожен атом, розташований у куті куба, належить одночасно восьми коміркам, і таких атомів 8, отже, на одну комірку приходиться $\frac{1}{8} \cdot 8 = 1$ атом.

Знаючи масу комірки $M_{\text{ком}}$ і її об'єм $V_{\text{ком}}$, можна розрахувати густину речовини полікристала

$$\rho = \frac{M_{\text{КОМ}}}{V_{\text{КОМ}}} = \frac{\left(\frac{\mu}{N_A}\right)N}{a^3}. \quad (12)$$

Тут μ - молярна маса зразка, N_A - число Авогадро, N - число атомів, що приходяться на одну комірку, a^3 - об'єм комірки.

Перелік посилань

1. Павлов Л.П. Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов. М., 1975
2. Шалимова К.В. Физика полупроводников. М., 1971.
3. Киреев П.С. Физика полупроводников. М., 1975.
4. Атомная диффузия в полупроводниках, под ред. Д.Шоу, М.: Мир, 1975.
5. Названов В.Ф. Основы оптоэлектроники. – Саратов: Изд-во Саратов ун-та, 1980.
6. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. – М.: Гос. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1963, глава 15.
7. Бузанова Л.К., Глиберман А.Я. Полупроводниковые фотоприемники. – М.: Энергия, 1976.
8. Геда Н.Ф. Измерение параметров приборов оптоэлектроники / Под ред. С.В. Свечникова. – М.: Радио и связь, 1981, глава 3.
9. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – 2-е изд. – М.: Сов. Радио, 1989.
10. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1990, глава 2.
11. Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника. – М.: Высшая школа, 2001, глава 11.
12. Филачев А.М., Таубкин И.И., Трищенко М.А. Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы. – М.: Физматкнига, 2005.
13. Розеншер Э., Винтер Б. Оптоэлектроника. – М.: Техносфера, 2006, глава 11.
14. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учебное пособие. 2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2007, глава 11.
15. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. – М.: Техносфера, 2006, глава 14.
16. Минаев В.В., Уздовский В.В., Сондаевский Р.В., Уздовский Вл.В. Исследование спектральных характеристик фотоприемников с барьером Шоттки на основе р-Si-Au// Изв. вузов. Электроника. – 2005. - №1. – С. 12-18.
17. Иванов А.В. Высокоэффективные быстродействующие р-і-п-диоды и фотоприемники на основе гетероструктур InP/InGaAs для волоконно-оптических систем передачи информации.// Лазерные новости. – 1997. - №2. – С. 31-32.
18. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. М.: Металлургия.- 1982.- 632 с.
19. Киреев П.С. Физика полупроводников. Учебное пособие для втузов. М.: ВШ, 1975.
20. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. М.: Металлургия . – 1971.- 366 с.